

H_1 МРЭ падает: увеличение j приводит к увеличению локально-го поля H_i и его угловой дисперсии, а малое внешнее поле H_1 не может существенно снизить угловую дисперсию намагниченности. Поле $H_2 \gg H_g(j_2)$, поэтому дисперсия намагниченности практически отсутствует, что и приводит к независимости МРЭ от тока в этом случае.

Список литературы

- [1] Дурачова Ю.А., Никитина Т.Н. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1965. Т. 29. № 4. С. 557-559.
- [2] Semenov D.I., Sidorenko V.V. // Phys. Stat. Sol. 1987. V. 101. N 2. P. 689-696.
- [3] Спицын В.И., Троицкий О.А. Электропластическая деформация металлов. М.: Наука, 1985. 160 с.
- [4] Вдовин Е.Е., Касумов А.Ю. // ФТТ. 1980. Т. 30. В. 1. С. 311-313.
- [5] Сидоренков В.В. // ДАН СССР. 1989. Т. 308. № 4. С. 870-873.
- [6] Сидоренков В.В., Семенцов Д.И., Корнин Ю.В. // ДАН СССР. 1990. Т. 310. № 6. С. 1371-1374.

Поступило в Редакцию
16 ноября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 4

26 февраля 1991 г.

06.3; 07

© 1991

ПАССИВНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ

А.Н. Залогин, С.М. Коэль,
В.Н. Листвин, А.В. Чуренков

В настоящее время активно разрабатываются пассивные волоконно-оптические датчики (ВОД) физических величин, чувствительным элементом которых является микрорезонатор, изготовленный путем анизотропного травления кремния [1]. Частотный выходной сигнал таких датчиков не искажается при изменении уровня оптической мощности, передаваемой по волоконному световоду, а чувствительный элемент может быть вынесен в зону повышенной радиоактивности, взрывобоязни и сильных электромагнитных помех, так как не содержит токовых цепей.

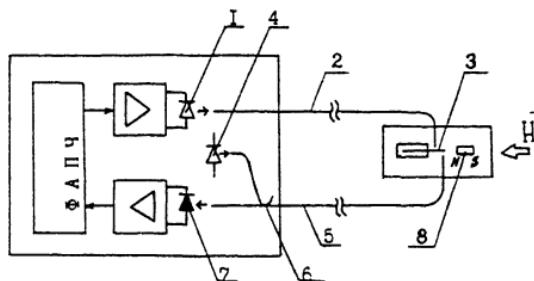


Рис. 1. Схема пассивного волоконно-оптического датчика магнитного поля с частотным выходом.

В настоящей работе сообщается о создании волоконно-оптического датчика магнитного поля с микрорезонатором, представляющим собой закрепленную с одной стороны консоль из магнитомягкого аморфного сплава (ММАС). Модуль упругости MMAС изменяется при наложении магнитного поля, и таким образом, осуществляется непосредственное преобразование измеряемой величины в частоту собственных колебаний микрорезонатора, что открывает новые возможности при конструировании пассивных ВОД физических величин.

Теория ΔE -эффекта в MMAС с направлением легкого намагничивания, перпендикулярным главной оси ленты, рассмотрена в работе Ливингстона [2]. В таких образцах преобладающими становятся пластинчатые домены с антипараллельными векторами \vec{M}_s , а процессы намагничивания практически полностью совершаются путем обратимого вращения доменов. В этом приближении зависимость модуля упругости от напряженности магнитного поля, направленного вдоль главной оси ленты, описывается выражением

$$\frac{1}{E_H} = \frac{1}{E_M} + \frac{g \lambda_s^2 H^2}{M_s H_A^3}, \quad H \leq H_A. \quad (1)$$

Здесь H_A – поле анизотропии, λ_s – постоянная магнитострикции.

Изменение модуля упругости материала консоли под действием внешнего магнитного поля вызывает изменение резонансной частоты основной моды изгибных колебаний консоли,

$$f = 6.38 \frac{b}{l^2} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (2)$$

где l – длина консоли, b – ее толщина, ρ – плотность материала, а коэффициент преобразования $S = \frac{df}{dH}$, как видно из (1) и (2), зависит от величины магнитного поля смещения H_0 и проходит через максимум при $H < H_A$.

Для изготовления микрорезонатора использовался сплав $Fe_{80}B_{14}Si_4C_2$, отожженный в течение нескольких минут при температуре кристаллизации. При таком режиме отжига из-за сжимаю-

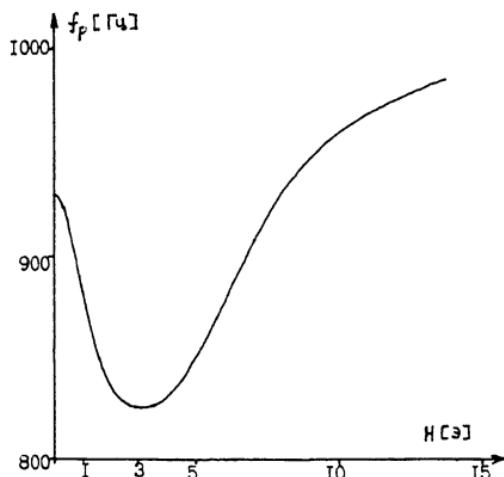


Рис. 2. Зависимость резонансной частоты от напряженности приложенного магнитного поля.

ших механических напряжений, возникающих при частичной кристаллизации материала, индуцируется легкая ось, перпендикулярная главной оси ленты [3]. После отжига петля гистерезиса имела стреловидную форму, а величина поля анизотропии, оцененная из начальной магнитной проницаемости, составила 3 Э.

Изгибные колебания консоли возбуждались за счет фотометрического эффекта промодулированным по амплитуде излучением лазерного диода 1 (см. рис. 1) (ИЛПН-202, $\lambda = 1.3$ мкм), подвешенным с помощью многомодового световода 2 к центральной части консоли (3). При мощности излучения диода 1 мВт и добротности $Q = 150$ амплитуда колебания консоли длиной $l = 5$ мм, шириной $a = 0.2$ мм и толщиной $b = 40$ мкм составила ~ 2 мкм.

Амплитуда колебаний консоли измерялась бесконтактным способом с помощью интерферометра Фабри-Перо низкого контраста, зеркала в котором образованы торцом одномодового волоконного световода и поверхностью консоли. При колебаниях консоли модулируется оптическая разность хода интерферирующих лучей и, соответственно, модулируется отраженная от интерферометра интенсивность излучения лазерного диода 4 (ЗДЛ-105, $\lambda = 0.85$ мкм).

Распространяясь обратно по одномодовому световоду 5, часть излучения через ответвитель 6 поступает на фотодиод 7. Каналы возбуждения и считывания были замкнуты через петлю фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), и в датчике, таким образом, возбуждалась генерация на частоте собственных колебаний микррезонатора.

На рис. 2 приведены результаты экспериментального исследования зависимости резонансной частоты основной моды изгибных колебаний консоли из ММАС от напряженности магнитного поля. Ход экспериментальной кривой согласуется с теоретической зависимостью для модуля упругости (1). На начальном участке при $H < H_0$

модуль упругости уменьшается и соответственно уменьшается резонансная частота колебаний консоли. При $H > H_A$ частота увеличивается, так как модуль упругости увеличивается до своего максимального значения E_m .

Максимальная величина коэффициента преобразования $S_3 = df/dH = 65 \text{ Гц/Э}$ достигается в поле смещения $H_0 = 0.6 \text{ Э},$ создаваемого *Sm-Co* магнитом (8, рис. 1) с размерами $5 \times 5 \times 12 \text{ мм}.$ При этом пороговая чувствительность датчика к магнитному полю в полосе частот $0.01-10 \text{ Гц}$ составила $H_{\min} = 60 \text{ нТл}.$ Как показывают оценки, согласно [2], возможно увеличение коэффициента преобразования вплоть до $S_T = 1500 \text{ Гц/Э},$ что соответствует при $\Delta f/f = 10^{-5}$ предельной чувствительности $H_{\min} \sim 1 \text{ нТл}.$

В заключение отметим, что предлагаемый пассивный ВОД магнитного поля с частотной формой представления выходного сигнала может быть использован для высокоточных измерений малых перемещений ($< 0.1 \text{ мкм}$) и тока.

Список литературы

- [1] Venkatesh S. // J. IERE. 1988. V. 58. P. S79-S84.
- [2] Livingston T.D. // Phys. Stat. Sol. (a). 1982. V. 70. P. 591-596.
- [3] Livingston T.D., Morris W.G. // IEEE Transactions on magnetics. 1981. V. 17. P. 2624-2626.

Московский
физико-технический институт

Поступило в Редакцию
25 ноября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 4

26 февраля 1991 г.

07; 12

© 1991

HeCd лазер с длиной волны 441.6 нм,
воздужаемый микросекундным пучком электронов

Д.Л. Кузнецов, Г.А. Месяц,
Ю.Н. Новоселов, В.В. Осипов,
В.В. Уварин

Генерация на ионах кадмия в *HeCd* смеси высокого давления реализована как при возбуждении продуктами ядерной реакции [1, 2], так и при накачке мощным наносекундным пучком электронов [3-5]. В последнем случае генерация зафиксирована только в по-